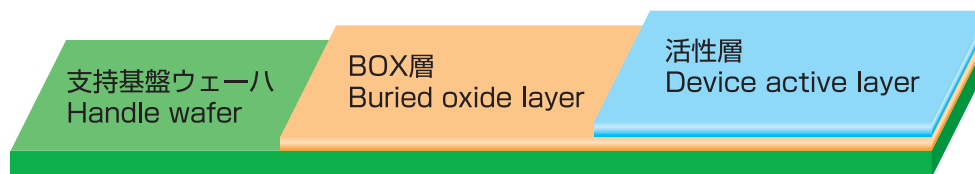


# 厚膜SOIウェーハ I

## Thick Film SOI Wafer

### SOI(Silicon On Insulator)



### 厚膜基板ウェーハ仕様 Specifications of thick film SOI wafer

直径(mm) Diameter(mm)	φ100,φ125,φ150
結晶方位 Orientation	(100),(111),(110)
ドーパント Dopant	N-type;Sb,P,As P-type;B
活性層厚さ(μm) Thickness of device active layer	2.0~200
活性層厚さ均一性(μm) Tolerance of device active layer	+/-0.5,+/-0.4(*)
BOX層厚さ(μm) Thickness of buried oxide film	0.1~3.0μm
BOX層厚さ均一性(%) Tolerance of buried oxide film	+/-5.0
外周形状 Wafer rim part	ラウンド Round with terrace free

\*0.4μm以下の製品については、ご相談に応じます。  
For product sizes 0.4μm and under, please consult us.

### テラスフリーSOI ウェーハ Terrace free SOI wafer

- 当社のウェーハには、テラスがありません No part of terrace exists on our wafer.

#### メリット Merits

有効面積が約7%増えます The effective area of wafer increase by around 7%

ポリッシュトウェーハと同様に取扱えます They can be handled in the same way as polished wafer

